

【訂正】

# 2024年12月期第3四半期業績報告

2024年11月14日

代表取締役社長 川上 潤

専務執行役員最高財務責任者 三木 晃彦



2024年11月14日に開示いたしました「2024年12月期第3四半期業績報告」の内容につきまして、以下訂正させていただきます。何卒よろしくお願い申し上げます。

【訂正箇所】

30ページ

製品別損益：多目的分析機器事業  
ページ右下にある、左側の円グラフの題名

訂正前	訂正後
2023年12月期第3四半期	2023年12月期通期

※ 訂正後の説明資料につきましては、次ページ以降にあらためて添付させていただいております。

# 2024年12月期第3四半期業績報告

2024年11月14日

代表取締役社長 川上 潤

専務執行役員最高財務責任者 三木 晃彦



**Rigaku**

POWERING NEW PERSPECTIVES

本資料は、リガク・ホールディングス株式会社（以下「当社」といいます）の企業情報等の提供のために作成されたものであり、米国、日本国またはそれ以外の一切の法域における当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。米国、日本国またはそれ以外の一切の法域において、適用法令に基づく登録若しくは届出またはこれらの免除を受けずに、当社の有価証券の募集または販売を行うことはできません。

本資料には、当社または当社グループに関連する見通し、計画、目標などの将来に関する記述がなされています。これらの記述には、「予想」、「予測」、「予定」、「期待」、「意図」、「計画」、「可能性」やこれらの類義語が含まれることがありますが、これらに限られるものではありません。これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報をもとに、本資料の作成時点における当社の判断に基づいて記載したものであり、また、一定の前提・仮定の下になされています。そのため、これらの記述または前提・仮定は、様々なリスクや不確定要素に左右され、実際の結果はこれと大幅に異なる可能性があります。このリスクや不確定要素には、例えばX線分析機器の需要の悪化、当社のブランド、製品及びサービスに関するレピュテーション、市場における競争状況、海外事業展開に伴うリスク、物価変動、為替変動、労働コストの変動、規制動向、事業成長戦略の遂行可能性、個人情報・機密情報の保護、裁判手続等の動向、大規模災害の発生その他の要因が含まれます。

当社の現在の決算期は12月末であります。また、当社は、2022年1月1日を移行日として、2022年12月期より国際財務報告基準（以下「IFRS」といいます）を採用しており、2022年1月1日より前の財務情報は日本基準に基づき作成されています。加えて、当社は、2021年4月1日付で株式会社リガクの持株会社になったため、2021年4月1日より前の財務情報は3月末を決算期とする株式会社リガクに係るものであります。本資料に記載されている2022年3月期の財務情報は、2021年4月から2022年3月における株式会社リガクと国内子会社の財務数値、2021年2月から2022年1月におけるRigaku Americas Holdingの財務数値、2021年1月から2021年12月におけるその他海外子会社の財務数値を基に管理会計ベースで記載しています。

本資料には、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後営業利益、調整後営業利益率、R&D比率、CAPEX比率、調整後当期利益、フリーキャッシュフローなど、当社のNon-IFRS指標に関する記述がありますが、これらはIFRS、日本基準その他の会計基準に基づく財務数値に代替するものではありません。かかるNon-IFRS指標の当社における使用、定義及び算定は、他社における同様の名称の財務指標とは大きく異なる可能性があり、直接的に比較することはできません。これらの財務数値の算出根拠等の詳細についてはAppendixをご参照ください。また、本資料には、製品区分別売上収益及び営業利益並びにエンドマーケット別売上収益等の管理会計ベースの財務情報が含まれています。当該財務情報は日本基準またはIFRSに基づき作成されたものではなく、監査を受けたものでもありません。

なお、本資料における記述は本資料の日付（またはそこに別途明記された日付）時点のものであり、当社は、それらの情報を最新のものに随時更新するという義務も方針も有していません。そのため、本資料に記載されている将来の見通しと実際の結果は必ずしも一致するものではありません。また、本資料に記載されている当社及び当社グループ以外の企業等に関する情報は、公開情報または第三者が作成したデータ等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について、当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。

# 業務内容および成長戦略

---

■ 多様なエンドマーケットに革新的なX線分析機器を提供するX線専門グローバル・リーディング・カンパニー

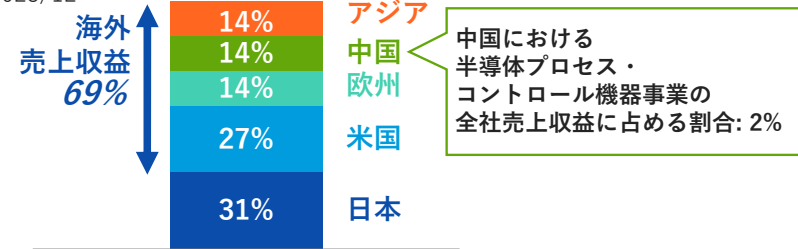
主要財務/KPIs

2023/12

売上収益 <b>798億円</b>	調整後EBITDA <sup>(1)</sup> <b>202億円</b>	調整後EBITDAマージン <sup>(1)</sup> <b>25%</b>	顧客数 <sup>(2)</sup> <b>10,000+</b>
売上収益CAGR 2021/3-2023/12 <sup>(3)</sup> <b>約24%</b>	海外売上収益CAGR <sup>(4)</sup> 2021/3-2023/12 <sup>(3)</sup> <b>約29%</b>	設立 <sup>(5)</sup> <b>1951</b>	従業員数 <sup>(6)</sup> <b>1,994人</b>

地域別売上収益比率<sup>(4)</sup>

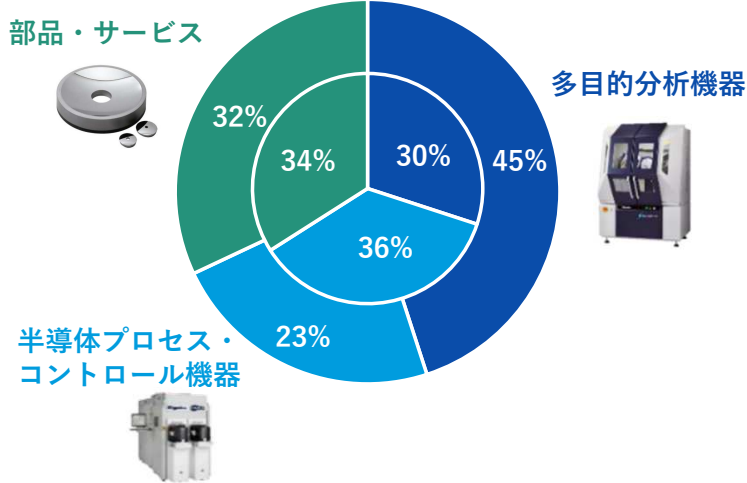
2023/12



製品区分別売上収益／営業利益構成<sup>(7)(8)</sup>

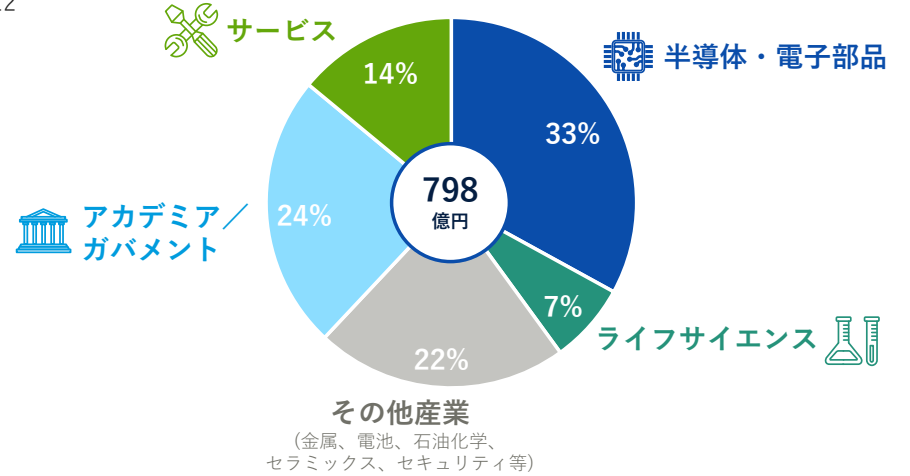
2023/12

外周: 売上収益  
内周: 営業利益



エンドマーケット別売上収益比率<sup>(8)</sup>

2023/12



注:  
 1. 調整後EBITDA = 税金等調整前当期利益 + 減価償却費及び償却費 + 減損損失 - 受取利息及び配当金 + 支払利息 + 一時費用  
 調整後EBITDAマージン = 調整後EBITDA / 売上収益  
 2. 2014年から2023年までの10年間にわたる出荷装置のエンドユーザー数  
 3. 2021年3月期 (J-GAAP、株式会社リガク) から2023年12月期 (IFRS、リガク・ホールディングス株式会社) までの2.75年間にわたるCAGR

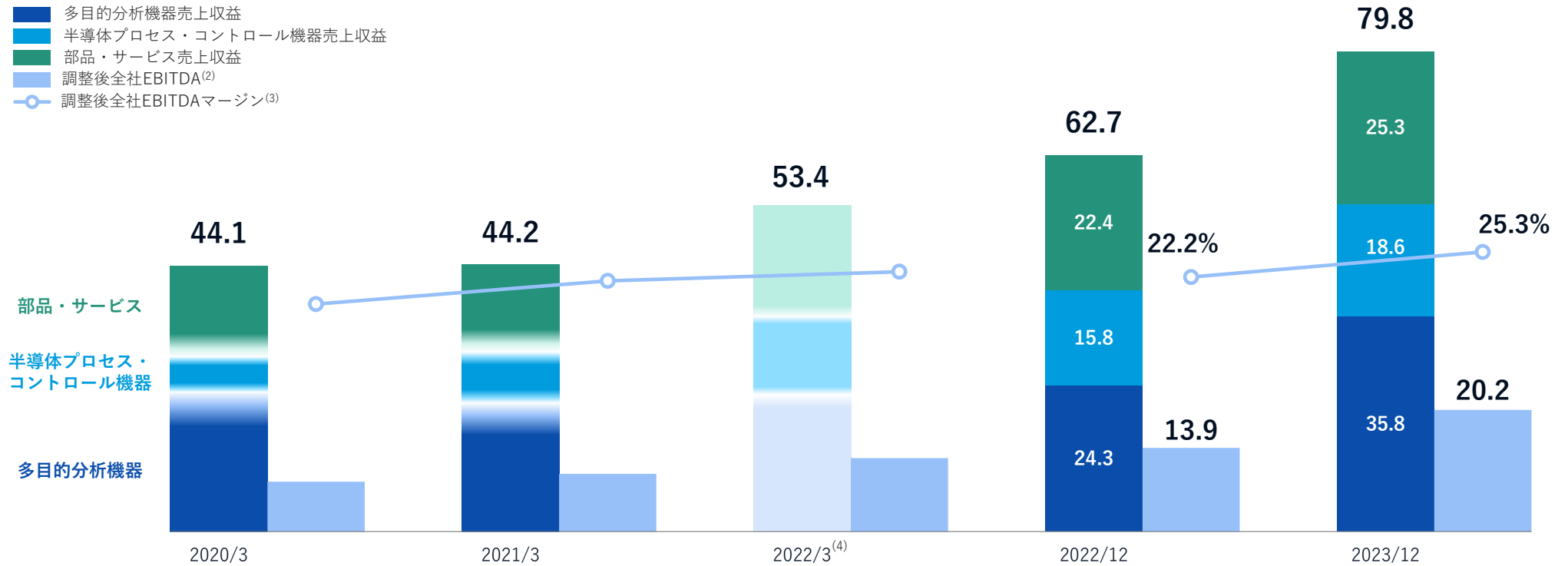
4. 海外の顧客・代理店に対する売上収益に基づき算出  
 5. リガク・ホールディングス株式会社の前身である理学電機株式会社の設立年。リガク・ホールディングス株式会社は2020年設立  
 6. 2023年12月末時点。256名の臨時雇用者を含む  
 7. 本社費用を除いた営業利益に基づき、製品区分別営業利益構成比を算出  
 8. 管理会計ベース

■ 半導体プロセス・コントロール機器の事業拡大が牽引し、売上収益成長とマージン拡大を実現

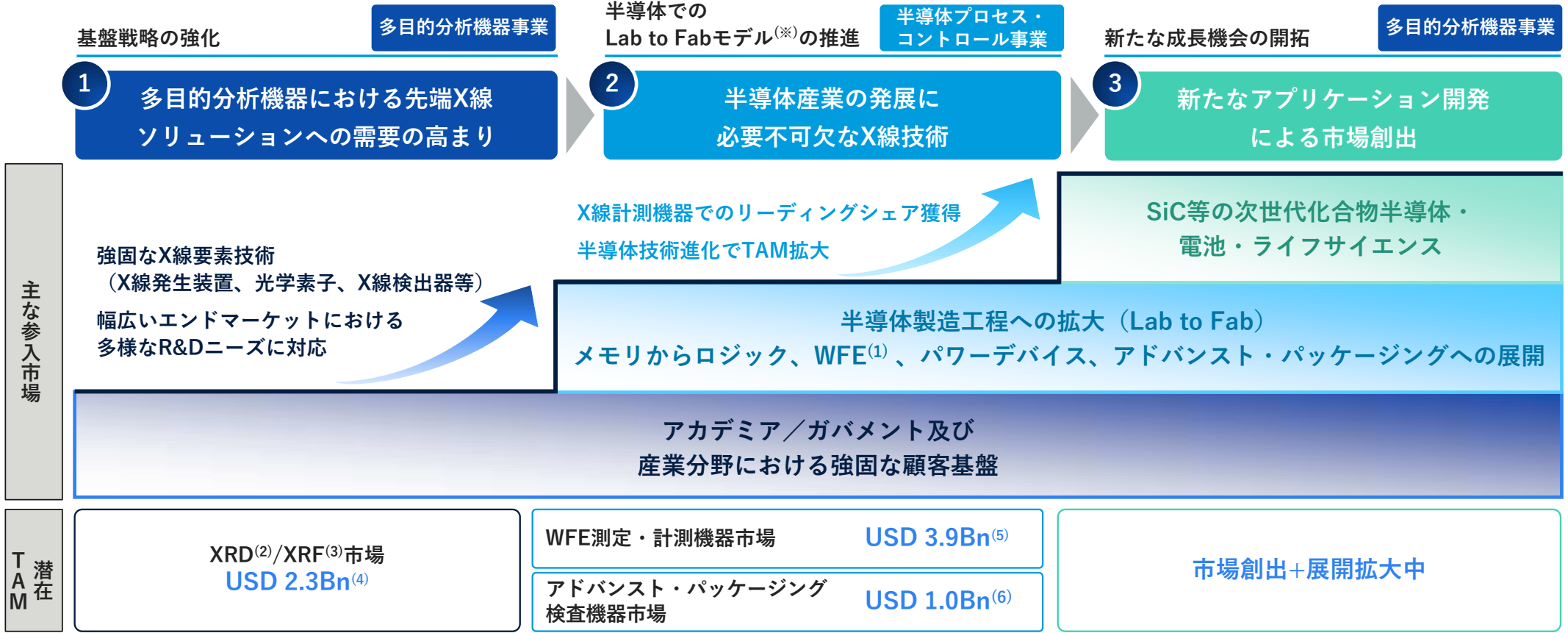
財務実績推移<sup>(1)</sup>

JPY Bn

- 多目的分析機器売上収益
- 半導体プロセス・コントロール機器売上収益
- 部品・サービス売上収益
- 調整後全社EBITDA<sup>(2)</sup>
- 調整後全社EBITDAマージン<sup>(3)</sup>



注:  
 1. 管理会計ベース。2020年3月期及び2021年3月期は株式会社リガクを頂点とする連結財務数値であり、J-GAAPベース。2022年12月期及び2023年12月期はリガク・ホールディングス株式会社を頂点とする連結財務数値であり、IFRSベース  
 2. 調整後EBITDA = 税金等調整前当期利益 + 減価償却費及び償却費 + 減損損失 - 受取利息及び配当金 + 支払利息 + 一時費用  
 3. 調整後EBITDAマージン = 調整後EBITDA / 売上収益  
 4. 株式会社リガクと国内子会社は、2021年12月31日を末日とする会計期間(9ヶ月)をもって、決算期末日を3月31日から12月31日に変更。他の決算期との比較を意味のあるものにするため2022/3は2021年4月から2022年3月における株式会社リガクと国内子会社の財務数値、2021年2月から2022年1月におけるRigaku Americas Holding, Inc.の財務数値、2021年1月から2021年12月におけるその他海外子会社の財務数値を管理会計ベースで記載。当該財務情報を用いて当社の年度間の財政状態及び業績を比較検討する際には注意を払う必要があり、これらの情報に過剰に依拠することはできない



(※) Lab to Fabモデル: Laboratory (研究所) からFabrication (工場・モノづくりの現場) へと事業対象を拡大していく戦略

注:  
 1. Wafer Fab Equipment 2. X-ray Diffraction 3. X-ray Fluorescence  
 4. Strategic Directions International, Inc. 「SDI Global Assessment Report 2024」における装置販売及びサービス売上を含む2023年グローバル市場規模  
 5. Yole Intelligence 「Wafer Fab Equipment Market Monitor - Q2 2024」におけるEllipsometers, Opto-acoustic, Optical CD, CD SEM, X-Ray Metrology, Defect Review and Metrologyの2023年市場規模合計  
 6. Yole Intelligence 「Wafer Fab Equipment Market Monitor - Q2 2024」における、Advanced Packaging WFE市場に含まれるMetrology & Inspectionの2023年市場規模を参照。Advanced Packaging WFE市場には前工程、後工程、アセンブリが含まれる

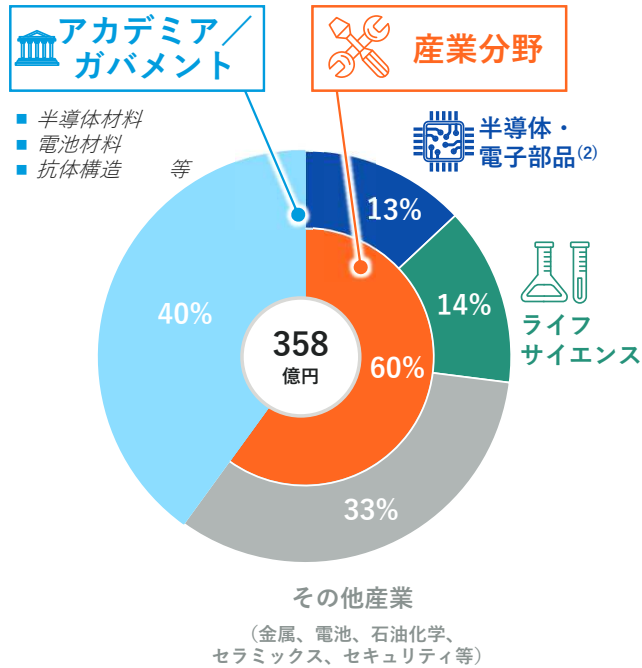


# ① 多目的分析機器における先端X線ソリューションへの需要の高まり

■ 競争力を有する要素技術の強みを活かした幅広い製品とアプリケーションにより、多様なエンドマーケットにおいて強固な顧客基盤を構築

## 多目的分析機器のエンドマーケット別売上収益<sup>(1)</sup>

2023/12

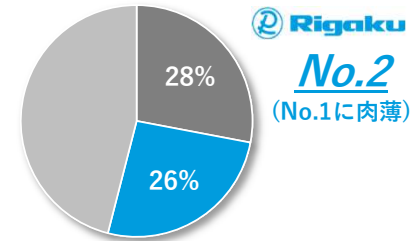


## 主要製品

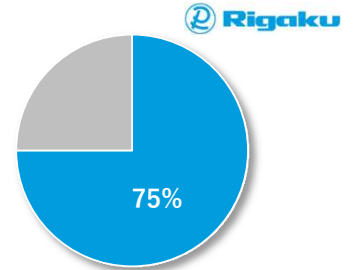
XRD		
<b>SmartLab</b>		
■ 最適な分析条件のガイダンス機能を搭載した多目的X線回折装置		
XRTmicron		
■ X線トポグラフィを活用した非破壊検査装置		
■ ウエハ製造における結晶欠陥検査でも活用		
半導体・電子部品	ライフサイエンス	その他産業
Life Science		
<b>XtaLAB Synergy-S</b>		
■ 高輝度X線源と半導体検出機を搭載した単結晶X線構造解析装置		
半導体・電子部品	ライフサイエンス	その他産業
XRI		
<b>CT Lab HX</b>		
■ デスクトップ型で高速/高解像度を実現した3D CT		
半導体・電子部品	ライフサイエンス	その他産業
XRF		
<b>ZSX Primus IV</b>		
■ 微量元素の迅速な定量が可能な走査型蛍光X線分析装置		
半導体・電子部品	ライフサイエンス	その他産業

## リガクの市場ポジション

X線回折機器 (XRD) グローバルシェア (2023) <sup>(3)</sup>



X線回折機器 (XRD) 国内シェア (2022) <sup>(4)</sup>



主要エンドマーケットにおけるリガクの顧客納入実績 既存顧客のリピート受注率<sup>(8)</sup>

半導体	10社 / グローバル上位10社 <sup>(5)</sup>
製薬	10社 / 国内上位10社 <sup>(6)</sup>
化学製品	10社 / 国内上位10社 <sup>(7)</sup>



XRDもしくはXRF製品に係る既存顧客との更新商談における受注率 (過去10年間)

注:  
 1. 管理会計ベース  
 2. 主にXRDによる化合物半導体のウエハ欠陥検査及び研究開発用途  
 3. Strategic Directions International, Inc. 「SDI Global Assessment Report 2024」における装置販売及びサービス売上を含む2023年グローバル市場シェア  
 4. R&D「科学機器年鑑 2023年版」における装置販売売上のみを含む2022年国内市場シェア  
 5. グローバル上位10社は、TechInsightsにおける半導体企業の2023年の設備投資ランキングに基づく  
 6. 国内上位10社は、東証上場株価指数において「医薬品」に分類される企業の2023年売上高ランキングに基づく  
 7. 国内上位10社は、東証上場株価指数において「化学」に分類される企業の2023年売上高ランキングに基づく  
 8. 2014年4月から2023年12月までの既存顧客とのXRDもしくはXRF製品に係る装置更新商談における受注獲得件数の割合

# Rigaku ③ 新たなアプリケーション開発による市場創出

## ■ Lab to Fabモデルの推進により、成長市場のイノベーションに寄与

	半導体／電子部品	電池／電池材料	ライフサイエンス
主要顧客	半導体ウエハメーカー パワーデバイスメーカー	車載用電池メーカー	大学／研究機関 製薬会社
先端ニーズ	SiC等の化合物半導体の 結晶欠陥及び結晶方位の検査ニーズ	車載用二次電池のインライン使用 に向けた3次元解析ニーズ	バイオ医薬品開発における タンパク質の構造解析ニーズ
リガクのソリューション	<p><b>XRTmicron</b></p> <p>■ X線トポグラフィ技術を利用した非破壊検査装置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>材料特性や性能に関する欠陥を短時間で可視化</li> <li>SiCの開発・量産工程に利用可能</li> <li>Fraunhoferとの共同開発</li> </ul> <p>2023/12より売上貢献拡大</p>	<p><b>MiniFlex XpC</b></p> <p>■ 電池材料を含む幅広い物質の品質管理に寄与する自動化対応XRD</p> <p><b>CT Lab HV</b></p> <p>■ 電池製品を分解せずに3次元かつ高速での欠陥解析が可能な産業用X線CT</p>	<p><b>XtaLAB Synergy-ED</b></p> <p>■ 極微小結晶の解析を実現した、日本電子との共同開発による電子回折構造解析プラットフォーム</p> <p><b>BioMAXS</b></p> <p>■ 溶液状態にあるたんぱく質の可視化</p>
成長戦略	インライン使用への装置最適化及びSEMI認証 <sup>(1)</sup> の取得	グローバル連携を通じたセールス強化 インラインにおける全数検査に向けた製品の改良	医薬品の研究開発や品質管理分野における拡販
関連市場CAGR	パワーデバイス用WFE +7.1% <sup>(2)</sup>	電池材料 +31.5% <sup>(3)</sup>	バイオ医薬品 +10.1% <sup>(4)</sup>

注：

1. 業界団体のSemiconductor Equipment and Materials Internationalによる製品認証  
2. Yole Intelligence 「Wafer Fab Equipment Market Monitor - Q2 2024」におけるCAGR (2023-2027予測)

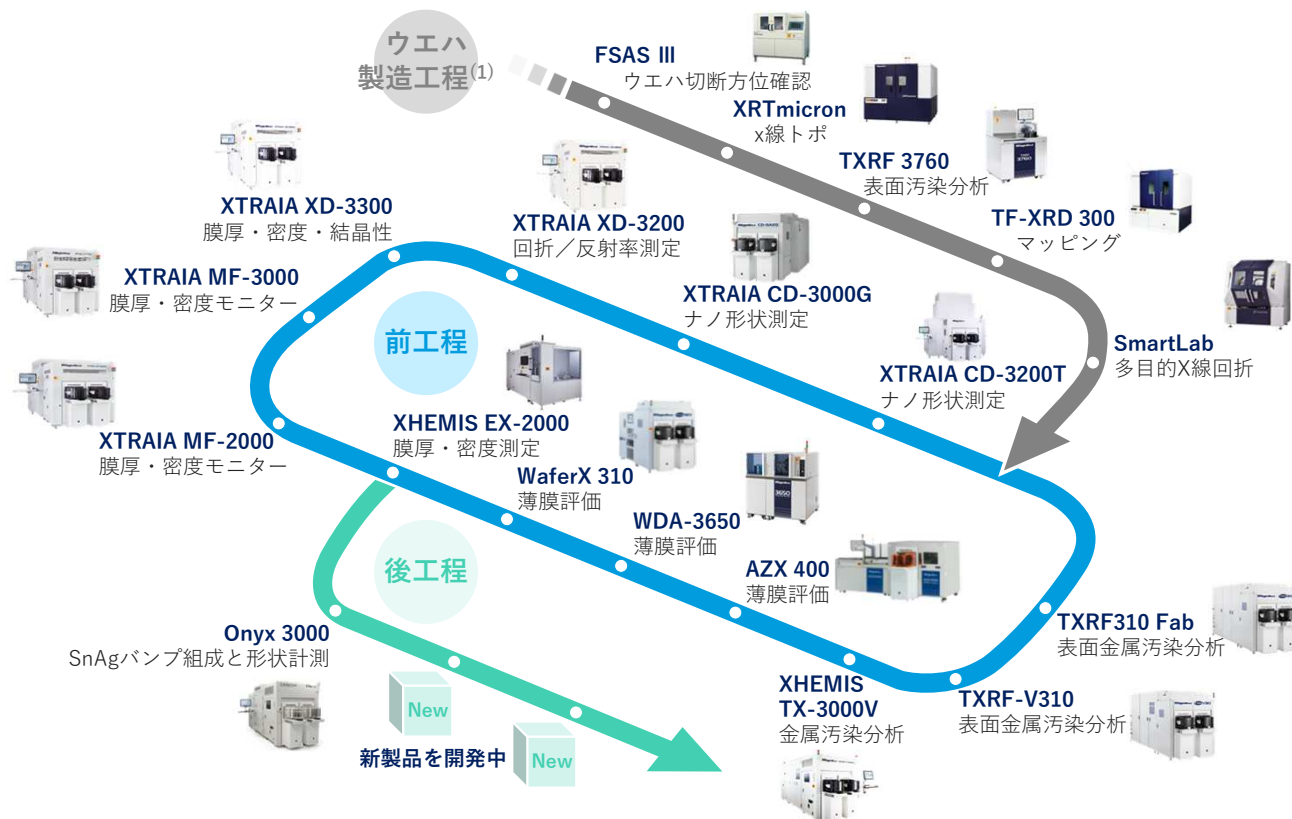
3. 富士経済「2022 電池関連市場実態総調査（下巻）＜電池材料市場編＞」に基づき当社が算出したCAGR (2020-2025予測)

4. STATISTA 「Global pharmaceutical revenue distributed by technology from 2012 to 2026 (in billion U.S.dollars)」(https://www.statista.com/statistics/309457/world-pharmaceutical-revenue-distribution-by-technology/より2024年8月28日取得)のEvaluate (2020年7月16日)に基づくCAGR (2023予測-2027予測)

## ② 半導体産業の発展に必要不可欠なX線技術～製造工程での製品展開

- 半導体製造工程における汚染検査や薄膜の膜厚・密度測定などで不可欠な製品ラインナップ
- リガクの製品は、ウエハ製造工程から前工程、後工程に至る幅広い工程をカバー

### 半導体の製造工程を支えるリガクの製品ラインナップ

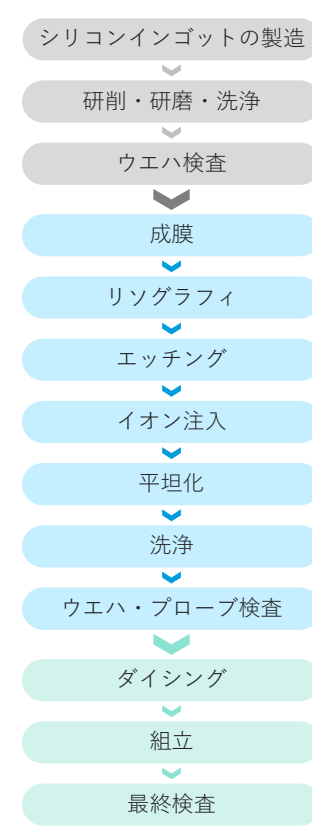


注:  
 1. ウエハ製造工程における機器のうち、FSAS III、XRTmicron、TF-XRD 300、SmartLabについては半導体プロセス・コントロール機器ではなく、多目的分析機器に該当  
 2. GAA=Gate All Around

### 各工程における検査・計測用途

工程	検査・計測用途
ウエハ製造工程	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ウエハ結晶内の欠陥検査</li> <li>■ ウエハ表面の汚染検査</li> <li>■ ウエハ結晶の方位測定</li> </ul>
前工程	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 薄膜化・多層化に伴うサブナノでの膜厚・密度の測定</li> <li>■ GAA<sup>(2)</sup>構造にも対応する非破壊での内部構造の評価</li> <li>■ 非破壊での深穴形状測定</li> </ul>
後工程	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 汚染や異物、傷等の検査</li> <li>■ チップレット集積で増加する接合部分の検査</li> </ul>

### 半導体製造工程



## ② 半導体産業の発展に必要なX線技術～半導体構造の微細化・複雑化による成長<sup>(1)</sup>

- 半導体構造の微細化・複雑化により、光学/CD計測市場がX線計測市場との共存領域に。WFE測定・計測機器市場におけるTAMはUSD3.9Bn<sup>(2)</sup>に拡大
- 「X線計測機器市場でのシェア拡大」「光学/CD機器の置換 or 併用」による市場創出で、X線市場の成長を上回ることを目指す

### WFE測定・計測機器市場におけるリガクのTAM拡大余地 (2023)<sup>(3)</sup>

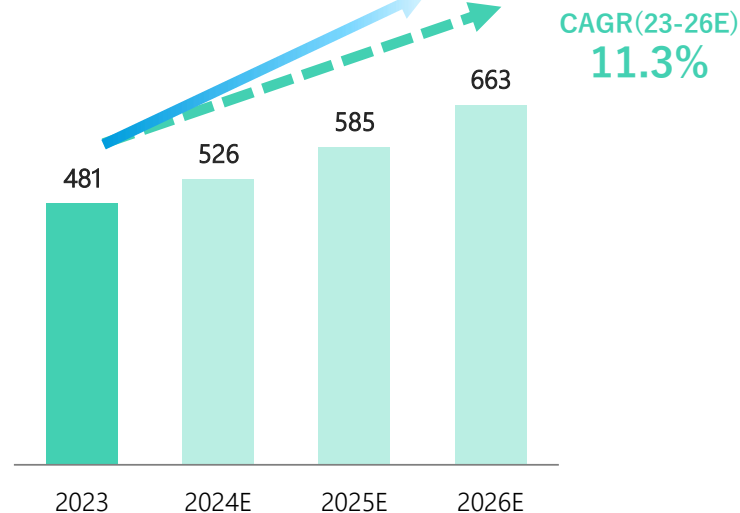
		市場規模 (2023) 成長率(23~26E)	主な サプライヤー	光学・CD測定機器の 課題 <sup>(8)</sup>	ユーザーの動向
TAM 拡大余地 <sup>(4)</sup> USD 3.4Bn	Defect Review and Metrology <sup>(5)</sup> (TEM <sup>(6)</sup> を含む)	USD 1,439MM CAGR5.5%	KLA Hitachi High-Tech	×OCD/CD-SEM単 独では深孔測定が 難しくなる傾向 ×幅10nm以下の 世代の解析が困難 になる傾向	・ TEMをCD SAXSで 置き換え、 CD-SAXS + OCD の併用を志向する 動き ・ OCDをCD SAXSに 置き換える動き
	CD SEM <sup>(7)</sup>	USD 644MM CAGR5.7%	Hitachi High-Tech		
	Optical CD	USD 854MM CAGR15.0%	KLA Nova Onto		
	Ellipsometers	USD 299MM CAGR12.0%	KLA Onto	×従来のエリプソ ンメーターでは極薄 膜の 測定が難しくなる 傾向	・ エリプソメーター をX線計測装置へ 置き換える動き
	Opto-acoustic	USD 162MM CAGR3.2%	Onto		
既存TAM USD 0.5Bn	X-Ray Metrology	USD 481MM CAGR 11.3%	Rigaku Bruker KLA Nova	半導体の微細化・積層化の進展で X線による技術補完が必要に	

### X線計測機器市場<sup>(3)</sup>とリガクの成長メカニズム

USD MM

中長期的に  
X線市場を上回る成長  
の実現を目指す

- ✓ X線による光学/CD機器の  
置き換えで、新市場を創出
- ✓ X線計測機器市場での  
シェア拡大
- ✓ 付加価値に見合った  
プライシング  
(2023/12: 営業利益率35%)



注:  
 1. 本ページに記載されている将来の見通しに関する記述は、当社のコントロールが及ばない事業、経済、規制、競合の不確実性及び偶発事象により、大きな影響を受ける可能性がある。これらの記述は、当社の将来の戦略や方針に関する一定の前提に基づいており、これらは変更される可能性がある。実際の将来数値は様々な要因により目標数値と異なる可能性があり、その差異が大きくなる可能性がある。本資料の内容は、これらの目標が達成されることを示すものではなく、また、状況の変化に応じて目標を更新する義務を負うものではない。  
 2. 既存TAM (USD 0.5Bn) とTAM拡大余地 (USD 3.4Bn) の市場規模合計  
 3. 市場規模及び成長率に関する情報はYole Intelligence 「Wafer Fab Equipment Market Monitor - Q2 2024」を参照  
 4. Yole Intelligence 「Wafer Fab Equipment Market Monitor - Q2 2024」におけるEllipsometers, Opto-acoustic, Optical CD, CD SEM, Defect Review and Metrologyの市場規模合計  
 5. ウエハの表面検査が可能な電子線やSEM(Scanning Electron Microscopes)の機器を指す  
 6. TEM=Transmission Electron Microscope  
 7. CD SEM=Critical Dimension Scanning Electron Microscopes  
 8. 当社認識

# Rigaku 中長期目標：持続的な約10%の売上収益CAGR

■ 約10%の売上収益CAGRと、20%台後半の調整後EBITDAマージン実現を目指す

中長期目標<sup>(1)</sup>

	2022/12	2023/12	中長期目標
売上収益 (YoY成長率)	627億円 15.7%	798億円 27.4%	売上収益CAGR： 約10%
調整後EBITDA <sup>(2)</sup> (調整後EBITDAマージン)	139億円 22.2%	202億円 25.3%	調整後EBITDAマージン： 20%台後半へ改善
調整後営業利益 <sup>(3)</sup> (調整後営業利益率)	143億円 22.9%	183億円 22.9%	調整後営業利益率： 20%台前半～半ばへ改善
R&D比率 <sup>(4)</sup>	7.1%	6.5%	R&D比率： 約9.0%
CAPEX比率 <sup>(5)</sup>	4.3%	3.5%	CAPEX比率： 約5.0%

注:

1. 中長期目標は、2024年2月時点の将来の目標であり、当社がコントロールできない事業、経済、規制及び競争上の重大な不確実性及び偶発事象の影響を受ける。また、当該目標は当社の将来の戦略・方針について一定の仮定に基づいて策定しており、それらは今後変更される可能性がある。実際の将来数値は様々な要因によって目標値から異なる可能性があり、その差異は大きなものとなる可能性がある。本資料に記載されている内容は、本目標が達成されることを示すものではなく、状況の変化に応じて本目標を更新する義務を負うものではない。特に、上記目標はUSD/JPYを135:1、EUR/JPYを147:1とした想定為替レートを2024年12月期以降全ての年に對して適用して算出。(比較のため、2023年12月期に対しても適及的に当該レートを適用して計算しており、当該数値は本頁には記載されていない。)
2. 調整後EBITDA = 税金等調整前当期利益 + 減価償却費及び償却費 + 減損損失 - 受取利息及び配当金 + 支払利息 + 一時費用  
調整後EBITDAマージン = 調整後EBITDA / 売上収益
3. 調整後営業利益 = 営業利益 + PPA償却費 + 減損損失 + 一時費用  
調整後営業利益率 = 調整後営業利益 / 売上収益
4. R&D比率 = 研究開発費 / 売上収益
5. 使用権資産を除く設備投資を用いて算出。CAPEX比率 = CAPEX / 売上収益

# 2024年12月期第3四半期連結決算概要

---

- **第3四半期累計業績**：売上 626億円 (YoY +11.5%)、営業利益 118億円 (YoY +7.7%)、税引後利益90億円 (YoY +19.5%)
- **多目的分析機器事業**：半導体向けXRTmicronの増加や中国補正予算の効果をはじめ、主要地域で増収傾向も、第3四半期では、主に大型案件における一部製品での納入遅延により、第4四半期への期ズレが発生
- **半導体プロセス・コントロール機器事業**：アドバンストロジック、ファウンドリ及びWFE向けを中心に堅調な業績。メモリは投資底打ちからの回復にやや遅れ
- **利益率**：売上増と製品ミックス効果により売上総利益率は改善しているが、第3四半期（7－9月）の納入遅延による売上減と継続したR&D及び人員の費用増により営業利益率は対前年で微減。第4四半期での回復を見込む
- **10月進捗**：第4四半期10月の月次進捗は順調

(百万円)	2023年12月期 第3四半期累計	2024年12月期 第3四半期累計	増減	増減率	主たる増減要因
売上収益	56,123	<b>62,580</b>	6,456	11.5%	・多目的分析：中国での補正予算、アジアでのXRD・XRFの伸長、欧州でのXRTmicron増加 ・半導体プロセスコントロール：ロジック、ファウンドリ、WFE向けが牽引。地域別では米州と中国が増加 ・為替影響
売上総利益	33,746	<b>38,262</b>	4,515	13.4%	
対売上収益比率	60.1%	<b>61.1%</b>	1.0pts		・半導体プロセス・コントロール機器およびサービスの売上と利益率向上
営業利益	11,003	<b>11,849</b>	846	7.7%	・(+ ) 売上総利益増 (-) 販管費増 (人件費、研究開発費、販売手数料など)
対売上収益比率	19.6%	<b>18.9%</b>	(0.7)pts		
税引前四半期利益	10,690	<b>11,544</b>	853	8.0%	
四半期利益	7,525	<b>8,990</b>	1,465	19.5%	・税引前利益増 + 法人税等減少 (研究開発費税額控除、米州売上比増など)
<b>Non-IFRS 指標</b>					
調整後四半期利益	8,853	<b>10,231</b>	1,378	15.6%	
調整後EPS	39.4	<b>45.4</b>	6.1	15.4%	
EBITDA	14,201	<b>15,436</b>	1,235	8.7%	
調整後EBITDA	14,304	<b>15,545</b>	1,241	8.7%	
対売上収益比率	25.5%	<b>24.8%</b>	(0.6)pts		
研究開発費	3,646	<b>4,732</b>	1,085	29.8%	・主に半導体市場向け製品の開発
対売上収益比率	6.5%	<b>7.6%</b>	1.1pts		
設備投資額	1,870	<b>3,619</b>	1,749	93.5%	・山梨工場増設工事
対売上収益比率	3.3%	<b>5.8%</b>	2.5pts		
フリーキャッシュフロー	3,900	<b>4,872</b>	971	24.9%	・営業キャッシュフロー増加
JPY/USD	139.6	<b>151.6</b>	12.0	8.6%	・第3四半期累計実績の前年対比における対USD1円あたりの為替感応度：売上収益約1.9億円、EBITDA約0.8億円
JPY/EURO	151.2	<b>164.6</b>	13.4	8.9%	

注：  
1. Non-IFRSの項目算出に関する調整項目についてはPage 25-27「調整項目」に詳細を記載



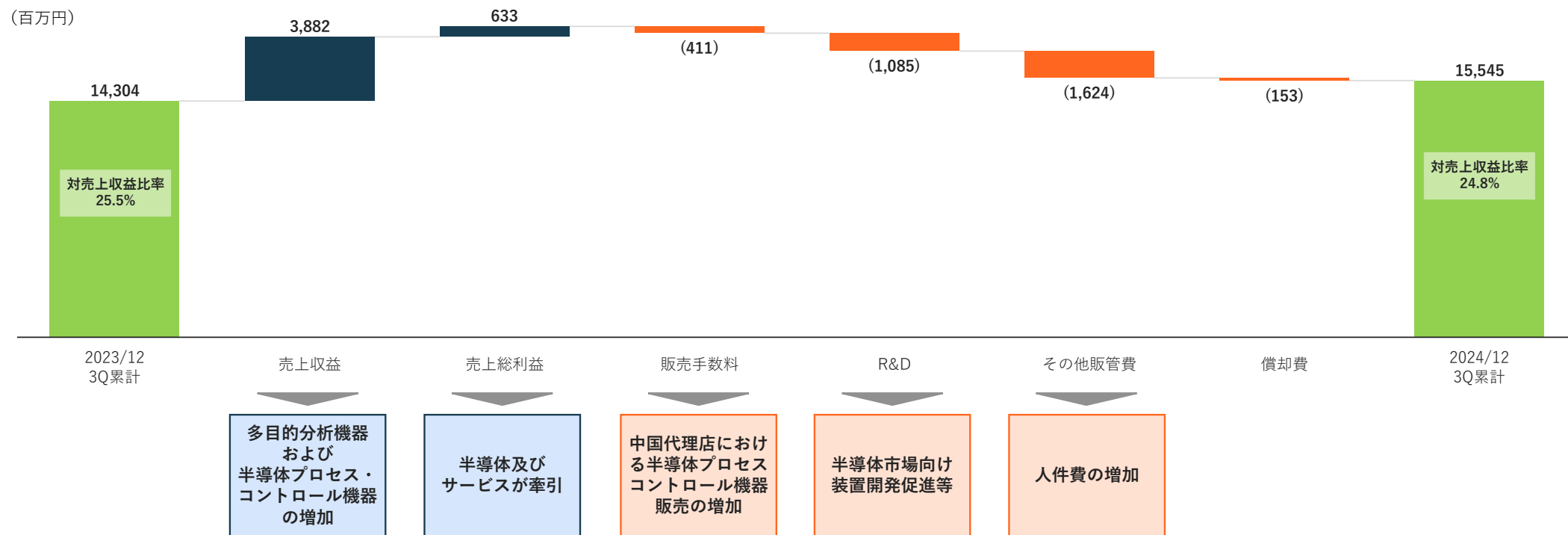
(百万円)	2023年12月期	2024年12月期	増減	増減率	主たる増減要因
	通期末	第3四半期末			
流動資産	61,030	<b>63,613</b>	2,582	4.2%	棚卸資産の増加（販売増加に向けた在庫積増など）
（現預金）	20,521	<b>21,735</b>	1,214	5.9%	
有形固定資産	15,265	<b>16,573</b>	1,307	8.6%	山梨工場増設工事
無形資産	86,824	<b>85,888</b>	(935)	(1.1)%	リース使用権資産、無形資産の償却による減少
資産合計	163,120	<b>166,075</b>	2,954	1.8%	
流動負債	30,190	<b>28,467</b>	(1,722)	(5.7)%	法人税の中間納付による未払法人所得税の減少
非流動負債	67,580	<b>63,180</b>	(4,400)	(6.5)%	コーポレートローンの返済、長期従業員給付の減少など
（有利子負債総額）	62,075	<b>59,066</b>	(3,008)	(4.8)%	
純資産	65,349	<b>74,427</b>	9,077	13.9%	利益剰余金の増加
負債・純資産合計	163,120	<b>166,075</b>	2,954	1.8%	
ネットデット/調整後EBITDA	2.1 x	<b>1.7 x</b>	(0.4) x		
自己資本比率 <sup>(1)</sup>	40.1%	<b>44.8%</b>	4.7pts		

(百万円)	2023年12月期	2024年12月期	増減	増減率	主たる増減要因
	第3四半期累計	第3四半期累計			
営業キャッシュフロー	5,471	<b>8,213</b>	2,742	50.1%	利益増、在庫増額の減少による
投資キャッシュフロー	(1,570)	<b>(3,341)</b>	(1,770)	112.7%	山梨工場、ERP投資など
フリーキャッシュフロー	3,900	<b>4,872</b>	971	24.9%	営業キャッシュフロー増加
財務キャッシュフロー	(3,715)	<b>(3,485)</b>	229	(6.2)%	(+) 山梨工場増設のための借入金 (-)コーポレートローン、リース債務の返済
ネットキャッシュフロー	1,328	<b>1,214</b>	(113)	(8.6)%	為替変動の影響により、対前年で減少

注：  
1. 2024年12月期第3四半期末の値はLTM合計の調整後EBITDAを用いて算出

# Rigaku 調整後EBITDA分析

- 多目的分析機器および半導体プロセス・コントロール機器ともに売上収益が増加したことに加え、半導体プロセス・コントロール機器とサービスの売上収益向上が利益率向上に寄与し、調整後EBITDAは前年同期比増加
- 対売上比率は、第3四半期(7月～9月)の納入遅延による売上減と継続したR&D及び人員の費用増により、前年同期比で低下



(百万円)	売上収益				営業利益				営業利益率		
	2023/12 3Q累計	2024/12 3Q累計	増減	増減率	2023/12 3Q累計	2024/12 3Q累計	増減	増減率	2023/12 3Q累計	2024/12 3Q累計	増減
多目的分析機器	24,392	<b>27,988</b>	3,595	14.7%	3,422	<b>3,892</b>	470	13.7%	14.0%	<b>13.9%</b>	(0.1)pts
半導体プロセスコントロール機器	13,523	<b>15,995</b>	2,471	18.3%	5,064	<b>5,432</b>	367	7.2%	37.4%	<b>34.0%</b>	(3.4)pts
部品・サービス	18,207	<b>18,596</b>	388	2.1%	4,339	<b>4,436</b>	97	2.2%	23.8%	<b>23.9%</b>	0.1pts
本社費	-	-	-	-	(1,823)	<b>(1,912)</b>	(88)	4.8%	-	-	-
<b>合計</b>	<b>56,123</b>	<b>62,580</b>	<b>6,456</b>	<b>11.5%</b>	<b>11,003</b>	<b>11,849</b>	<b>846</b>	<b>7.7%</b>	<b>19.6%</b>	<b>18.9%</b>	<b>(0.7)pts</b>

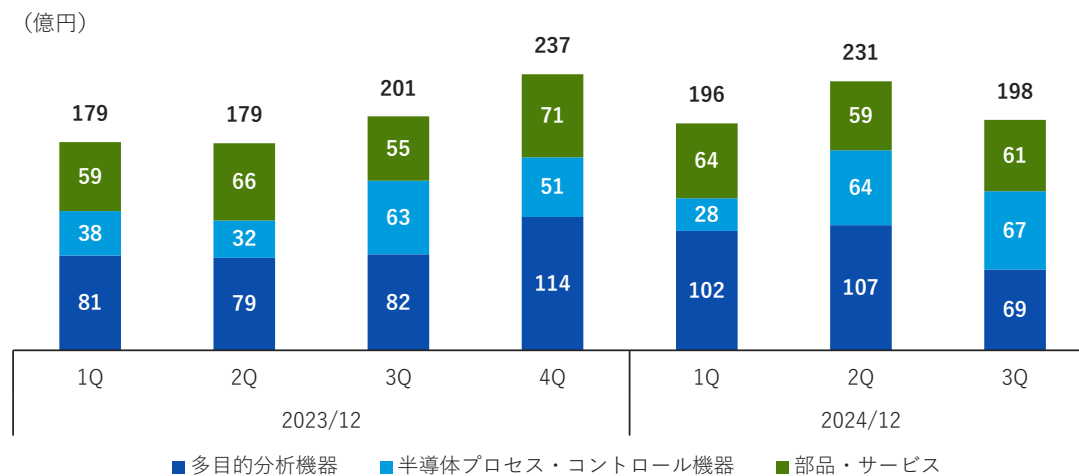
**2024年12月期 第3四半期累計（1-9月）**

- 先端ロジック半導体メーカー向け販売の伸長
- 多目的分析機器の中国市場向け出荷増（2023年補正予算案件の受注品）
- 半導体プロセス・コントロール機器の販売手数料増による営業利益率の低下
- 為替影響

**2024年12月期 第3四半期（7-9月）**

- 多目的分析機器において、大型案件での顧客への納入遅れに伴い、前年同期比で売上収益が減少
  - 欧米におけるXRD機器の4Qシフト
  - 中国におけるLS<sup>(1)</sup>の検収手続き遅延による4Qシフト

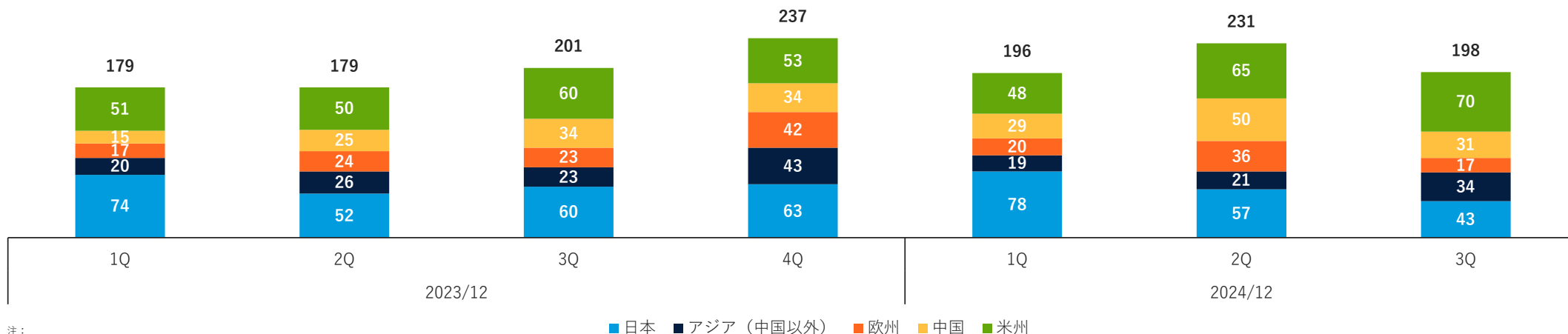
事業別売上収益推移



注：  
1. LS = Life Science

(百万円)	2023年12月期	2024年12月期	増減	増減率	主たる増減要因
	第3四半期累計	第3四半期累計			
売上収益合計	56,123	62,580	6,456	11.5%	
日本	18,732	17,987	(745)	(4.0)%	半導体プロセス・コントロール機器の売上遅延、EUVの顧客在庫調整による減少
アジア（中国以外）	7,082	7,540	458	6.5%	多目的分析機器が牽引
欧州	6,558	7,442	884	13.5%	半導体向け多目的分析機器（XRTmicron、TFXRD）の販売増、為替影響
中国	7,498	11,050	3,552	47.4%	補正予算案件および半導体レガシーデバイス向け製品の伸長
米州	16,250	18,530	2,280	14.0%	半導体プロセス・コントロール機器売上の伸長、為替影響

(億円) 地域別売上収益推移

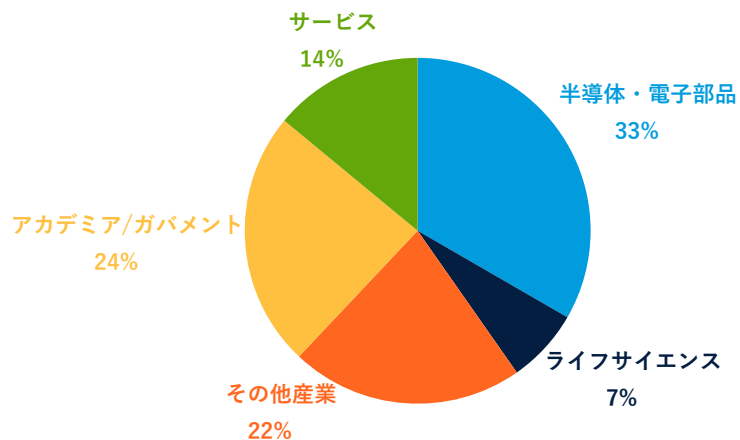


注：  
1. 海外の顧客・代理店に対する売上収益に基づき算出

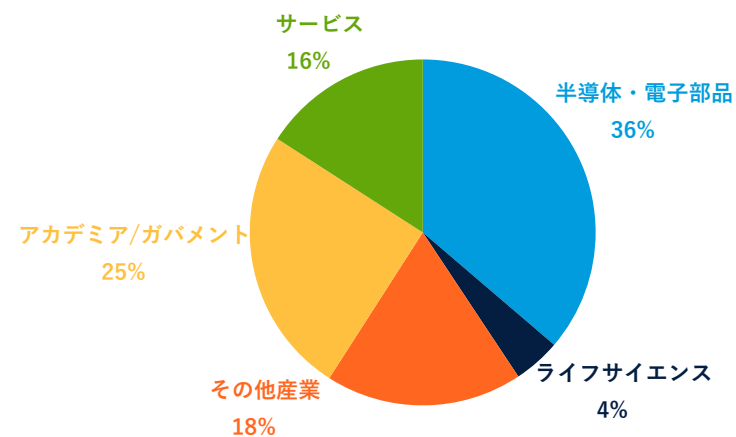
**Rigaku** エンドマーケット別売上 (管理会計ベース)

(百万円)	2023年12月期	売上収益比率%	2024年12月期	売上収益比率%	コメント
	通期		第3四半期累計		
売上収益合計	79,887	100%	62,580	100%	-
半導体・電子部品	26,641	33%	22,684	36%	アドバンスト・ロジック、ファウンドリ及びWFEが牽引
ライフサイエンス	5,539	7%	2,768	4%	製薬業界向けが対前年減少
その他産業	17,377	22%	11,517	18%	-
アカデミア/ガバメント	19,134	24%	15,667	25%	日本の大学・官庁向けが3月に集中するため
サービス	11,193	14%	9,942	16%	-

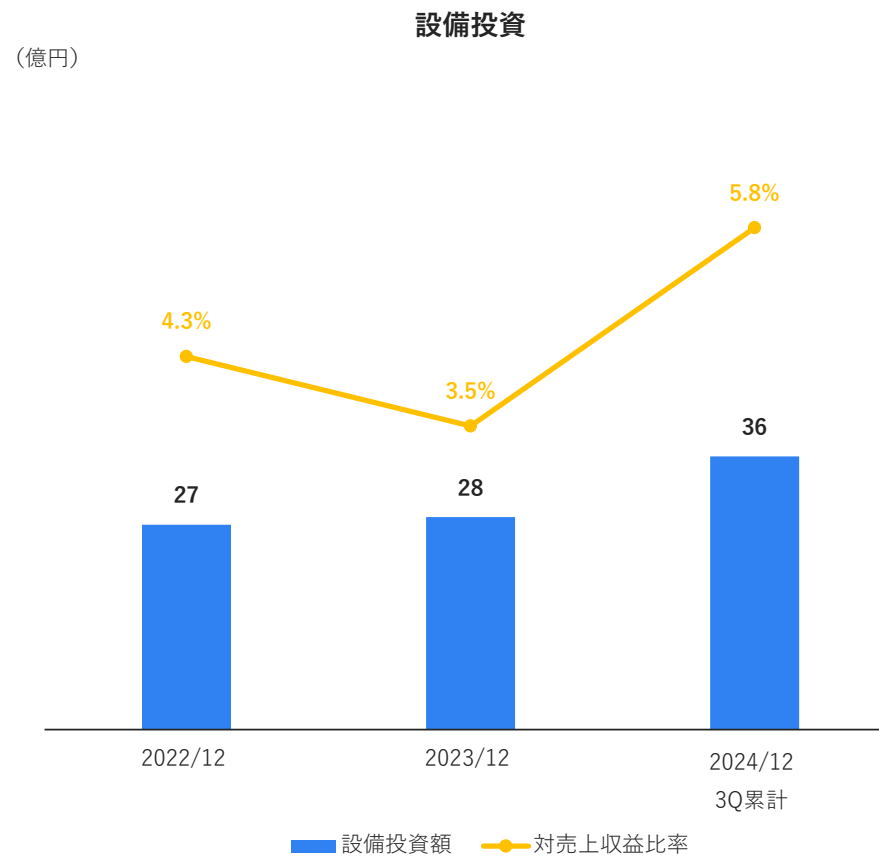
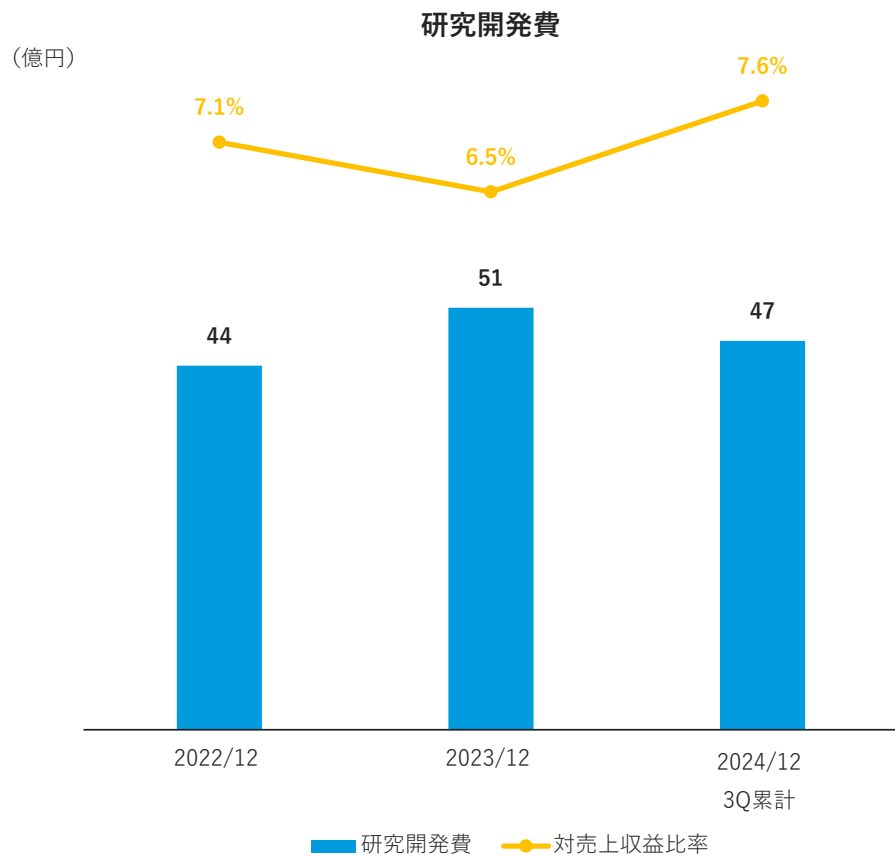
2023年12月期 通期



2024年12月期 第3四半期累計



■ 研究開発費は戦略的に増大。設備投資は今期山梨工場増設により一時的に増加

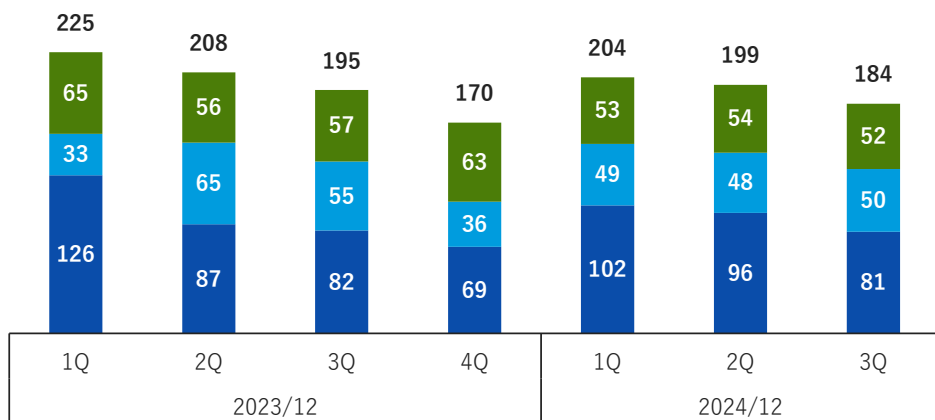


## Rigaku 製品別受注高・受注残の推移

- 2023年の中国補正予算による特需、2024年のEUV顧客の在庫調整、サプライチェーンの正常化等により、受注・受注残は減少傾向
- パイプラインは堅調に増加しており、生産キャパシティの拡大によるリードタイムの改善、半導体市場の高い投資意欲と強い引き合いへの的確な対応、市場ニーズの高いアプリケーションへの取り組み等により、受注高の成長を図る

(億円)

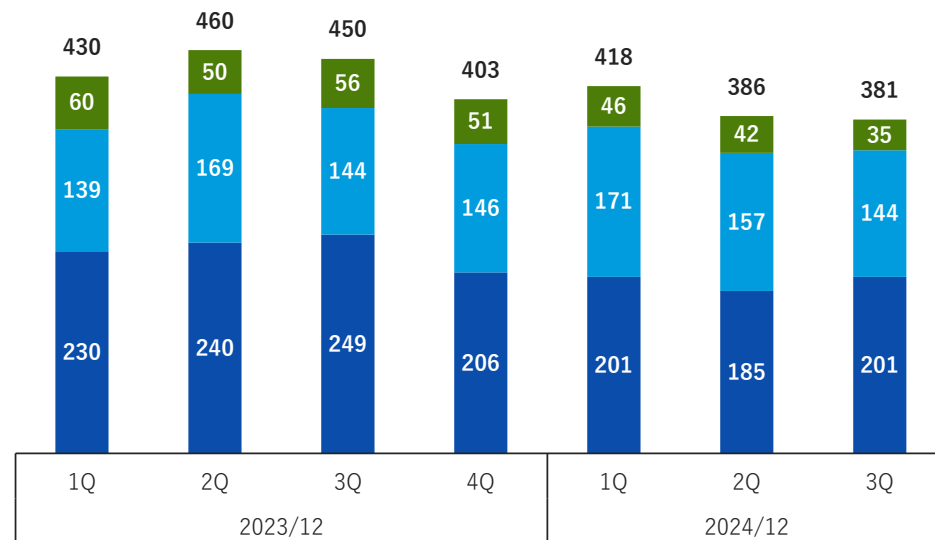
四半期毎受注高



■ 多目的分析機器 ■ 半導体プロセス・コントロール機器 ■ 部品・サービス

(億円)

四半期毎受注残



■ 多目的分析機器 ■ 半導体プロセス・コントロール機器 ■ 部品・サービス

## 2024年12月期連結業績予想

---



■ グループ全体では前年度比10.8%増の売上収益88,500百万円を見込む

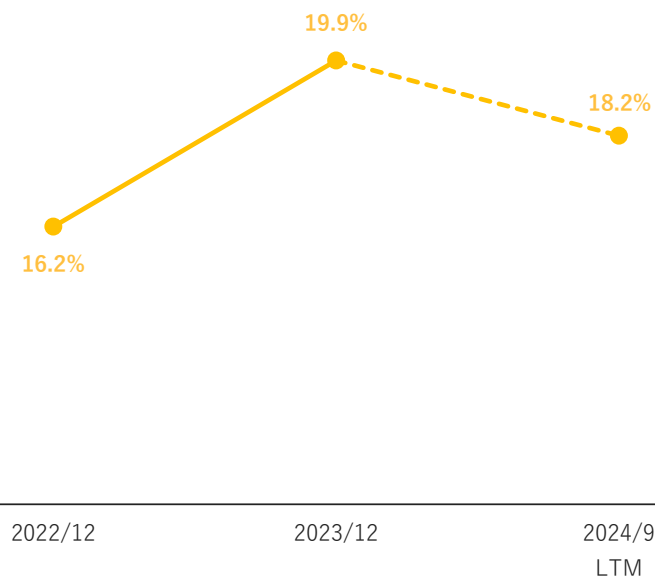
(百万円)	2023年12月期		2024年12月期		
	第3四半期累計実績	通期実績	第3四半期累計実績	通期予想	前期比
売上収益	56,123	79,887	62,580	<b>88,500</b>	10.8%
EBITDA	14,201	19,663	15,436	<b>22,000</b>	11.9%
調整後EBITDA	14,304	20,229	15,545	<b>22,600</b>	11.7%
利益率	25.5%	25.3%	24.8%	<b>25.5%</b>	0.2pts
営業利益	11,003	15,256	11,849	<b>17,394</b>	14.0%
利益率	19.6%	19.1%	18.9%	<b>19.7%</b>	0.6pts
調整後営業利益	12,988	18,315	13,686	<b>20,230</b>	10.5%
利益率	23.1%	22.9%	21.9%	<b>22.9%</b>	-
当期利益	7,525	10,904	8,990	<b>11,909</b>	9.2%
利益率	13.4%	13.6%	14.4%	<b>13.5%</b>	(0.1)pts
調整後当期利益	8,853	12,984	10,231	<b>13,900</b>	7.1%
利益率	15.8%	16.3%	16.3%	<b>15.7%</b>	(0.6)pts
基本的1株当たり当期利益	33円43銭	48円44銭	39円91銭	<b>52円87銭</b>	9.1%
調整後基本的1株当たり当期利益	39円33銭	57円68銭	45円42銭	<b>61円71銭</b>	7.0%

## 株主還元方針

### 連結配当性向: 30%程度を目指す

- 成長投資を最優先に、株主の皆様に対する安定的・継続的な利益還元を実施することを経営の重要課題と位置づけ
- 収益及びキャッシュ・フローの状況等を総合的に勘案した上で、当期連結利益に対して配当性向30%程度を目指す
- 2024年度の配当に関しては上場後期間を考慮し、予想連結利益の30%に対する2カ月分相当である一株当たり2.60円を予想

## 調整後自己資本利益率（ROE）



# Appendix.

---

## 調整後利益等における調整項目 (1/3)

(百万円)	2023年12月期				2024年12月期					
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第3四半期 累計	第1四半期	第2四半期	第3四半期	前年同期比	第3四半期 累計	前年同期比
税引前利益	3,317	3,165	4,207	10,690	3,036	5,409	3,098	(1,109)	11,544	853
減価償却費及び償却費	1,020	1,093	1,080	3,193	1,212	1,235	1,190	110	3,638	444
支払利息	148	170	122	441	161	173	174	51	509	68
受取利益及び配当金	(32)	(52)	(40)	(124)	(76)	(73)	(106)	(65)	(256)	(131)
EBITDA	4,454	4,377	5,370	14,201	4,334	6,744	4,357	(1,012)	15,436	1,235
利益率	24.8%	24.4%	26.6%	25.3%	22.1%	29.1%	22.0%	(4.6)%	24.7%	(0.6)%
IFRS導入費用	10	11	21	43	0	0	0	(21)	0	(43)
コンサルティング・フィー	7	7	7	22	7	7	7	0	22	0
中国免除申請関連費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他費用	7	16	13	36	14	23	48	35	85	49
調整項目計	25	35	42	102	21	30	56	14	108	5
調整後EBITDA	4,479	4,412	5,412	14,304	4,355	6,775	4,413	(998)	15,545	1,240
利益率	24.9%	24.6%	26.8%	25.5%	22.2%	29.3%	22.3%	(4.5)%	24.8%	(0.6)%

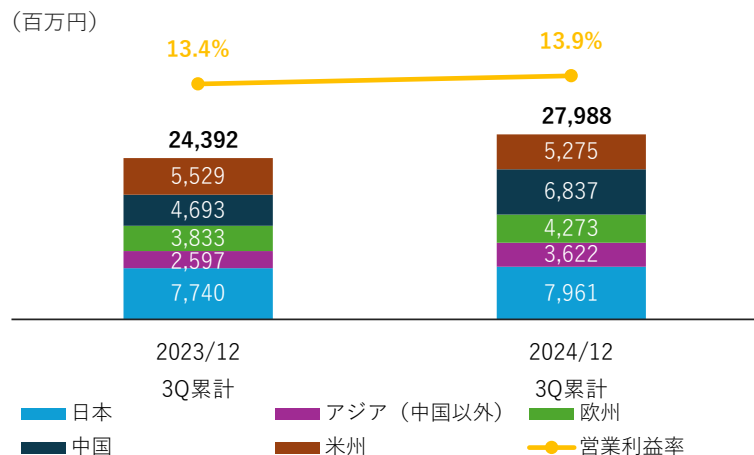
## 調整後利益等における調整項目 (2/3)

(百万円)	2023年12月期				2024年12月期					
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第3四半期 累計	第1四半期	第2四半期	第3四半期	前年同期比	第3四半期 累計	前年同期比
営業利益	3,429	3,289	4,284	11,003	3,160	5,511	3,176	(1,108)	11,849	846
利益率	19.1%	18.3%	21.2%	19.6%	16.1%	23.8%	16.0%	(5.2)%	18.9%	(0.7)%
PPA償却費	623	628	630	1,882	600	589	538	(92)	1,728	(153)
IFRS導入費用	10	11	21	43	0	0	0	(21)	0	(43)
コンサルティング・フィー	7	7	7	22	7	7	7	0	22	0
中国免除申請関連費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他費用	7	16	13	36	14	23	48	35	85	49
調整項目計	648	663	673	1,985	621	620	595	(78)	1,837	(147)
調整後営業利益	4,077	3,952	4,957	12,988	3,782	6,132	3,771	(1,186)	13,686	698
利益率	22.7%	22.0%	24.6%	23.1%	19.3%	26.5%	19.0%	(5.5)%	21.9%	(1.3)%

## 調整後利益等における調整項目 (3/3)

(百万円)	2023年12月期				2024年12月期					
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第3四半期 累計	第1四半期	第2四半期	第3四半期	前年同期比	第3四半期 累計	前年同期比
当期利益	2,163	2,461	2,900	7,525	2,185	4,322	2,482	(417)	8,990	1,465
利益率	12.0%	13.7%	14.4%	13.4%	11.1%	18.7%	12.5%	(1.8)%	14.4%	1.0%
PPA償却費	623	628	630	1,882	600	589	538	(92)	1,728	(153)
IFRS導入費用	10	11	21	43	0	0	0	(21)	0	(43)
コンサルティング・フィー	7	7	7	22	7	7	7	0	22	0
中国免除申請関連費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他費用	7	16	13	36	14	23	48	35	85	49
調整項目計	648	663	673	1,985	621	620	595	(78)	1,837	(147)
調整項目に対する 税金等調整額	(216)	(217)	(222)	(657)	(204)	(201)	(190)	32	(595)	61
調整後当期利益	2,594	2,907	3,350	8,853	2,602	4,741	2,887	(463)	10,231	1,378
利益率	14.4%	16.2%	16.6%	15.8%	13.3%	20.5%	14.6%	(2.0)%	16.3%	0.6%

売上収益／営業利益率



2024年12月期 第3四半期実績 ハイライト

- 中国では2023年度受注の中国補正案件の売上計上が多目的分析機器の売上増を牽引
- 日本ではXRDの汎用機 (SmartLab、Miniflex) が伸長
- アジアにおける営業力強化に伴うXRD・XRFの伸長
- 欧州では(XRTmicron、TFXRD等の大型機の増加に加え、為替影響もプラス要因
- エンドマーケット別では、アカデミア/ガバメント案件が3月に集中するため比率が高くなる中、半導体・電子部品市場向けの売上比率が増大している

主要製品

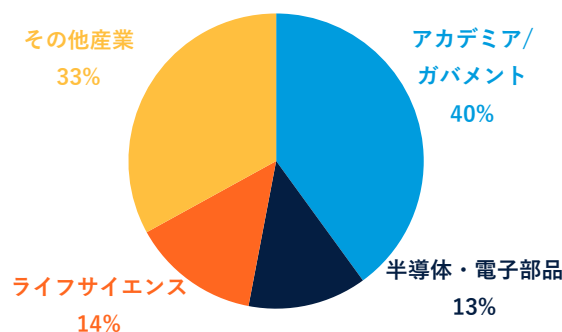


SmartLab

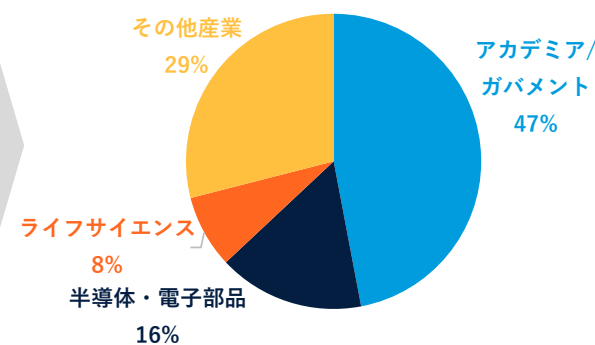


XRTmicron

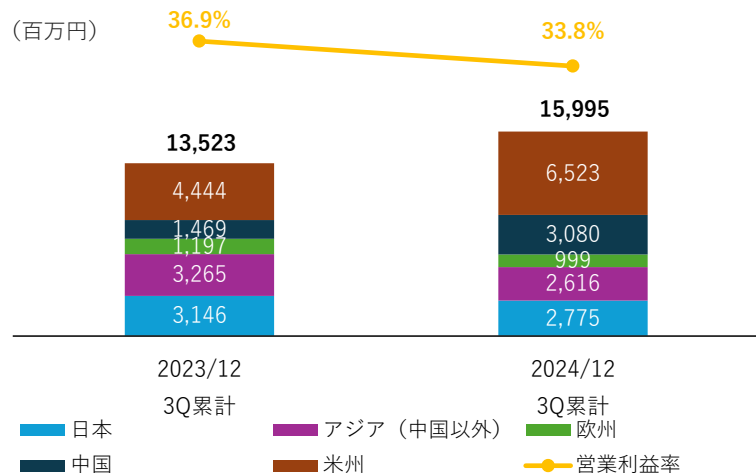
2023年12月期通期



2024年12月期第3四半期



## 売上収益／営業利益率



## 2024年12月期 第3四半期実績 ハイライト

- 米州および中国における売上増が半導体プロセスコントロール機器の売上増を牽引
- 米州の顧客にMFM310 が各生産拠点に導入され、それに伴いアドバンストロジック／ファウンドリのシェアが増大
- メモリはアジアの顧客へのMFM310の導入が当該期間でなかったため、第3四半期累計ベースではシェアは低下。メモリメーカーの23年底打ちからの回復ペースもやや緩慢
- WFEは日本の半導体製造装置メーカーの海外拠点向けに複数台導入案件があり、シェアは拡大

## 主要製品

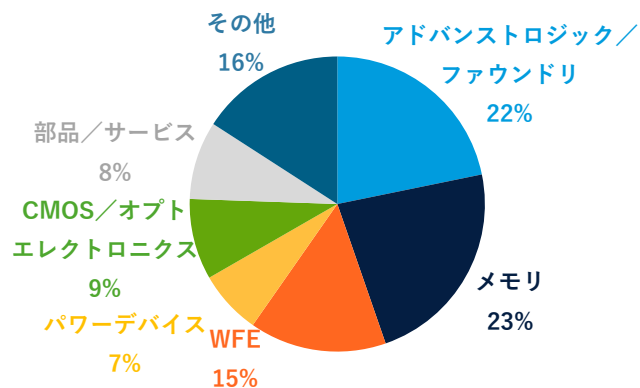


WaferX 310

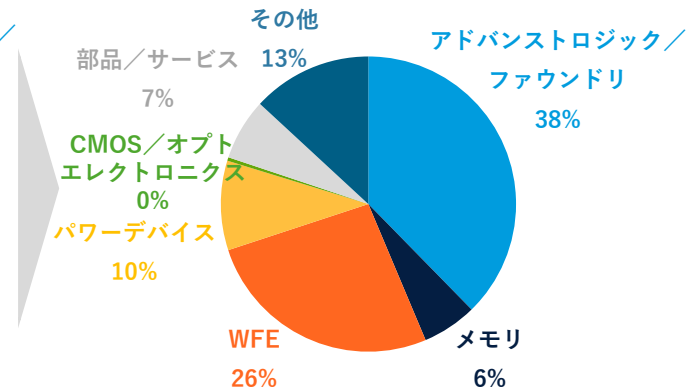


XTRAIA MF-3000(MFM310)

2023年12月期第3四半期

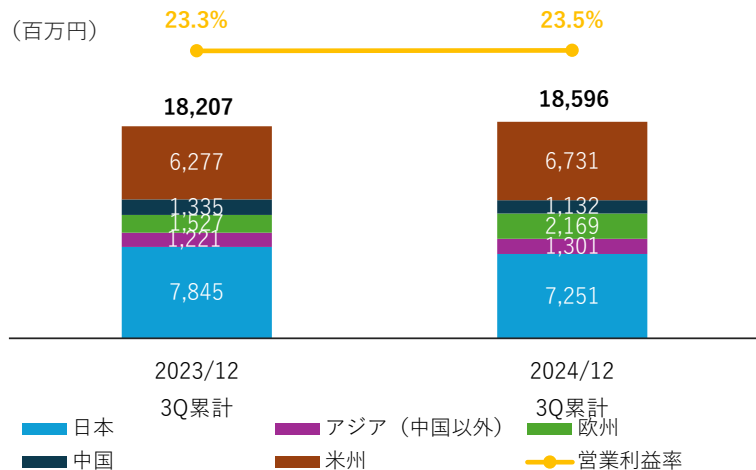


2024年12月期第3四半期





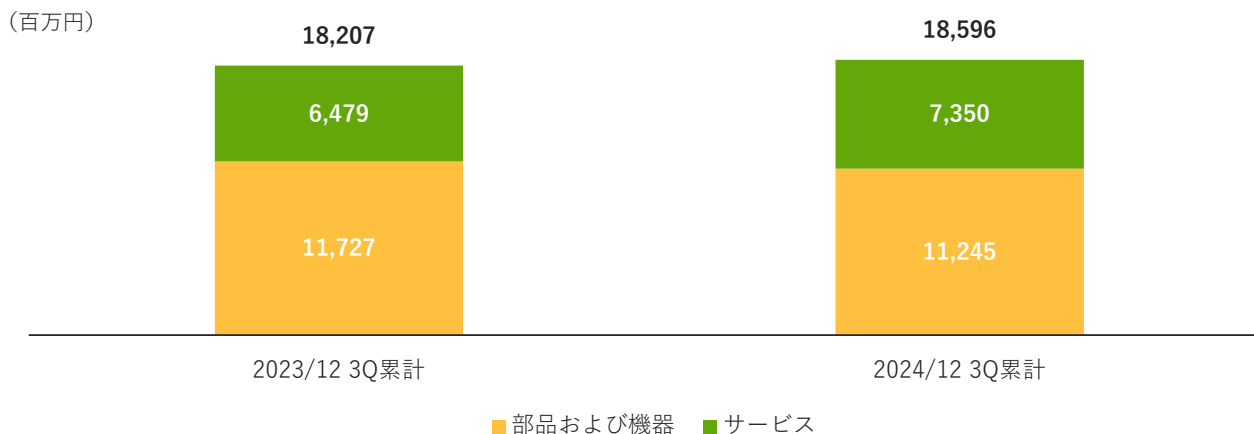
売上収益／営業利益率



2024年12月期 第3四半期実績 ハイライト

- サービスが9億円増加、その他は5億円の減少
- 日本では、顧客の在庫調整に伴うEUV向け多層膜ミラーの販売の停滞
- 欧州ではサービスとMILabsが増加
- 中国ではMILabsが受注遅延により低進捗
- 米州はサービス、ラマンが増加する一方で、日本と同様にEUVは停滞

部品および機器/サービス 売上収益



主要製品



Progeny



多層膜ミラー

用語	説明
<b>X-Ray Diffraction (XRD)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>結晶試料にX線を照射するとき生じる回折パターンから試料の結晶構造情報を得る手法。粉末試料、加工材料試料などの解析が可能</li> </ul>
<b>X-Ray Fluorescence (XRF)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>物質にX線を照射したときに発生する蛍光X線を利用して、定性分析や定量分析を行う元素分析手法。波長分散型（WDX）とエネルギー分散型（EDX）に大別される</li> </ul>
<b>X-Ray Imaging (XRI)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>X線画像及びX線を用いた断層撮影法</li> </ul>
<b>X-Ray Topography (XRT)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>結晶試料にX線を照射して回折するX線の強度を記録し、2次元マッピング画像として撮影・観察する、イメージング技術による非破壊評価の手法。さまざまな結晶材料内の欠陥を視覚化し、品質をモニタリングする際に用いられる</li> </ul>
<b>Backside PDN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Backside Power Delivery Networkの略称。電源回線を、従来技術である半導体チップまたはICの表側に代えて、裏側で配線する技術で、これによってロジック密度が高まり、出力と性能が向上する</li> </ul>
<b>CD SAX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>透過小角X線散乱（TSAXS）や微小角入射小角X線散乱（GISAXS）の技術によりナノスケールの立体内部構造や表面形状を評価する限界寸法計測手法</li> </ul>
<b>CD SEM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>半導体ウェーハ上に形成された微細パターンの寸法を測定する専用システム。主に半導体電子デバイスの製造ラインで用いられる</li> </ul>
<b>CFET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Complementary Field-Effect Transistorの略称。GAAアーキテクチャの進化系であり、2次元配置していたN型FETとP型FETを3次元で積層する</li> </ul>
<b>CT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Computed Tomographyの略称。X線とコンピュータ技術を組み合わせて撮影対象物の3次元内部画像を生成するシステム</li> </ul>
<b>Ellipsometer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>偏光の扁平率を測定する装置。薄膜の膜厚測定に用いられる</li> </ul>
<b>EMIB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Embedded Multi-die Interconnect Bridgeの略称。パッケージ内における異なるチップを高密度で相互接続する技術。他の技術で一般的に見られる大型シリコンインターポーザを使用する代わりに、EMIBでは複数のルーティング層を持つ非常に小型のブリッジダイが使用される</li> </ul>

用語	説明
EUV Lithography	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extreme Ultraviolet Lithographyの略称。従来技術の193nmの波長光に代わり、13.5nmという極端紫外線を用いた露光技術を指す</li> </ul>
GAA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gate All Aroundの略称。トランジスタ技術の一種で、ゲートがすべての側面からチャンネルに接触し、継続的な小型化を可能にするトランジスタ構造を指す</li> </ul>
ゴニオメーター	<ul style="list-style-type: none"> <li>X線源、試料、検出器の間の相対的な角度を精密に変化させる機構</li> </ul>
HBM	<ul style="list-style-type: none"> <li>High Bandwidth Memoryの略称。低消費電力かつ極めて広い帯域幅を持つ新型メモリチップ。スタック内およびメモリとロジックの間の両方で、極めて広いデータチャンネルを提供する標準化された積層メモリ技術</li> </ul>
NMR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuclear Magnetic Resonanceの略称。NMR機器は、強力な磁場を与えられた原子核の回転の相互作用を観察・測定することによって、試料の分子構造を分析することが可能。非破壊的な測定手法であり、試料の事前準備が少ないことがメリットながら、既存物質を収録するデータベースとの照合による推定分析となる</li> </ul>
Optical CD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optical Critical Dimensionの略称。Scatterometry（光波散乱計測）とも呼ばれる技術で、デバイスから三次元の周期的光学情報を取得する。半導体製造における光学計測およびプロセスコントロールに用いられ、広帯域光の反射を測定することによって試料の特性評価が可能</li> </ul>
Opto-acoustic	<ul style="list-style-type: none"> <li>音響波を使用して、接合ウエハスタックの表面下の欠陥、膜厚、空隙を検査、測定する機器</li> </ul>
ラマン分光分析	<ul style="list-style-type: none"> <li>試料にレーザー光を照射した際に発生するラマン散乱光を検出し、試料の化合物状態や結晶構造の情報を得ることでその分析を行う手法</li> </ul>
SEMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>国際半導体製造装置材料協会。エレクトロニクス業界において製品設計・製造事業を展開する会員企業で組織されるグローバル業界団体</li> </ul>
SiC	<ul style="list-style-type: none"> <li>シリコン(Si)と炭素(C)で構成される化合物半導体材料</li> </ul>
WFE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wafer Fab Equipmentの略称。ウェーハを回路形成・検査するプロセスにおける製造装置を指す</li> </ul>